トランジスタ

2\$B909M 2\$B1237

エピタキシァルプレーナ形 PNP シリコントランジスタ 中電力増幅用/Medium Power Amp. Epitaxial Planar PNP Silicon Transistors

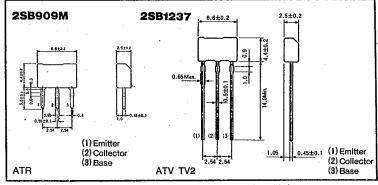
● 特長

- 1) Pc=1Wと大きい。
- 2) V_{CE (sat)}=-0.2V(at-0.5A) と低く, 低電圧動作に適している。
- 3) 2SD1225M/2SD1858とコンプリ。

Features

- 1) High power: Po=1W.
- Low saturation voltage (V_{OE(sat)}=-0.2V at -0.5A). Suitable for use in low-voltage.
- 3) Complementary pair with 2SD1225M, 2SD1858.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit:mm)



注:ATVの外形仕様については、TV3/4/6タイプも用意しています (p.38参照)。

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Limits	Unit	
コレクタ・ベース間電圧	V _{CBO} —40		٧	
コレクタ・エミッタ間電圧	VCEO	-32	٧	
エミッタ・ベース間電圧	VEBO	-5	٧	
コレクタ電流	lo1		Α	
コレクタ損失	Po	1	w*	
接合部温度	ΤJ	150	ç	
保存温度範囲	Tstg	−55~150	ొ	

* ブリント基板: コレクタ部分の銅箔面積1cm²以上, 厚み1.7mm

● 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit	Conditions	
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV _{CEO}	-32	<u> </u>	Γ-	٧	Ic=-1mA	
コレクタ・ベース降伏電圧	BV _{CBO}	-40	_	-	٧	1c=-50μA	
エミッタ・ベース降伏電圧	BVEBO	-5	_	-	٧	le=-50 μA	
コレクタしゃ断電流	Ісво		_	-0.5	μA	V _{CB} =-20V	
エミッタしゃ断電流	lEBO	-	_	-0.5	μΑ	V _{EB} =-4V	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	VCE(sat)	_	_	-0.5	٧	Ic/IB=-500mA/-50mA*	
直流電流増幅率	hFE	82	. —	390	_	VCE /IC=3V/-100mA	
利得帯域幅積 (トランジション周波数)	fT	50	150	_	MHz	VcE =-5V, IE=50mA	
出力容量	Cob		20.	30	pF	V _{CB} =-10V, I _E =0, f=1MH;	

* パルス測定

hfeの値により下表のように分類します。

Item	Р	Q:	R	
hre	82~180	120~270	180~390	

標準品・準標準品一覧表

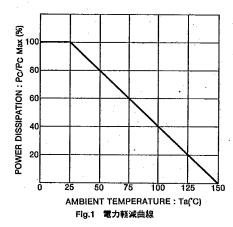
10	持张	\sim	٠	米福港 月

	T	包装名	バルク	コンテナ	テート	ニング
		記号		C2	TV2	TV3
Туре	hFE	基本発注単位(個)	1 000	4 000	2 500	2 500
2SB909M	PQR		0	0	_	_
2SB1237	PQR		-	_	0	0

RCHII

205

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves



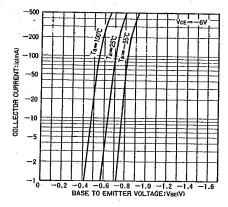


Fig.2 エミッタ接地伝達静特性

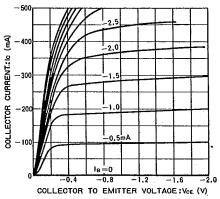


Fig.3 エミッタ接地出力静特性

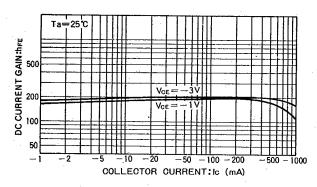


Fig.4 直流電流増幅率一コレクタ電流特性

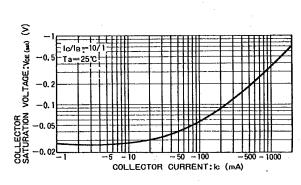


Fig.5 コレクタ・エミッタ飽和電圧―コレクタ電流特性

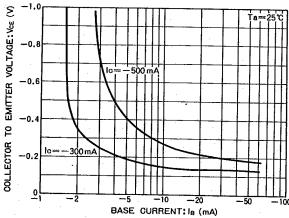


Fig.6 コレクタ・エミッタ電圧-ベース電流特性

206

ROHIT

www.DataSheet.in

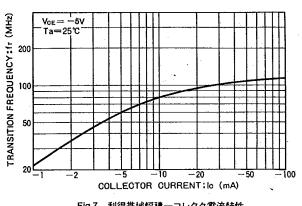
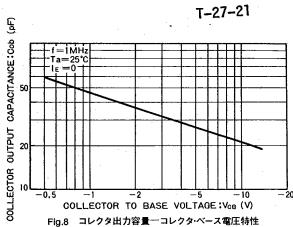
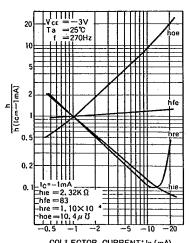


Fig.7 利得帯域幅積一コレクタ電流特性

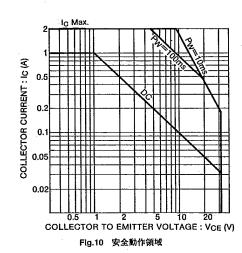


トランジスタ

258タイプ



COLLECTOR CURRENT: lc (mA) Fig.9 h定数一コレクタ電流特性



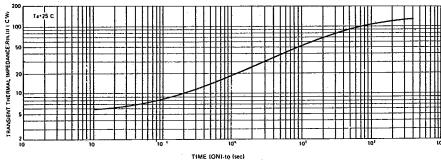


Fig.11 過渡熱抵抗